

## SAYISAL LOJİK AİLELER

SAYISAL ELEMANLAR SADECE LOJİK İŞLEMLERİ İLE DEĞİL AYNI ZAMANDA AİT OLDUKLARI TEKNOLOJİYE GÖREDE SINIFLANDIRILIRLAR

·ILK LOJİK İŞLEM AİLESİ:

•RTL: DİRENÇ TRANZİSTOR LOJİK •DTL: DİYOT TRANZİSTOR LOJİK

**•STANDART OLARAK KABUL EDİLEN LOJİK AİLE:** 

•TTL: TRANZISTOR TRANZISTOR LOJÍK

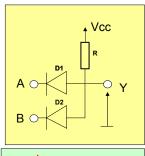
•YÜKSEK HIZLI İŞLEM AİLESİ •ECL: EMİTTER BAĞLAMALI LOJİK

•YÜKSEK ELEMAN YOĞUNLUĞU OLAN TÜMDEVRELER:

•MOS: METAL OKSIT YARIILETKEN

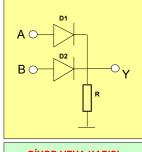
•DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMİ OLAN TÜMDEVRELER:

•CMOS: COMPLEMENTARY (TÜMLEYİCİ) MOS

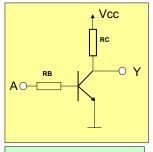


**DİYOD AND KAPISI** 

$$\begin{aligned} &\text{Vcc=V}_{\text{R}}\text{+}\text{ V}_{\text{D}}\text{+}\text{ V}_{\text{A}} \\ &\text{Vcc=5v iken} \\ &\text{V}_{\text{D1}}\text{=}\text{ V}_{\text{D2}}\text{=}5\text{V} \implies \text{V}_{\text{Y}}\text{=}? \\ &\text{V}_{\text{D1}}\text{=}\text{ V}_{\text{D2}}\text{=}4\text{V} \implies \text{V}_{\text{Y}}\text{=}? \\ &\text{V}_{\text{D1}}\text{=}\text{ 0V}, \text{ V}_{\text{D2}}\text{=}5\text{V} \implies \text{V}_{\text{Y}}\text{=}? \end{aligned}$$



**DİYOD VEYA KAPISI** 



TRANZISTOR NOT KAPISI

Vcc= Vce + Ic.Rc

Vce= Vcc - IcRc

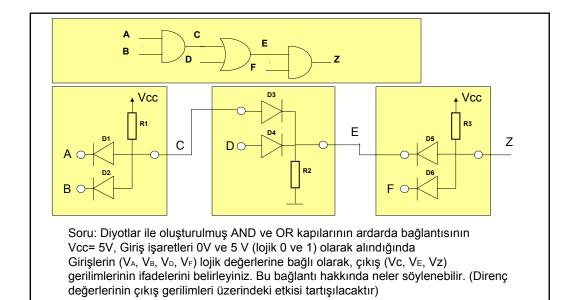
=  $Vcc - \beta.I_b.Rc$ =  $Vcc - \beta.(Va-Vbe).Rc/Rb$ =  $Vcc - \beta.(Va-0.6).Rc/Rb$ 

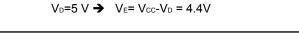
Vce≤ Vce(sat) iken

Ic= ( Vcc-Vce(sat) )/ (Rc+Rce(sat))

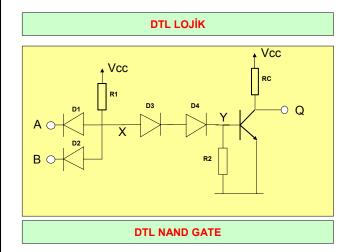
Rce(sat) ≤ 50Ω

Ic= ( Vcc-Vce(sat) )/ Rc olarak hesaplanır



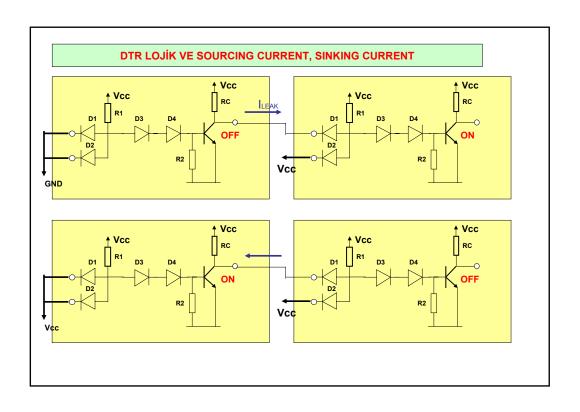


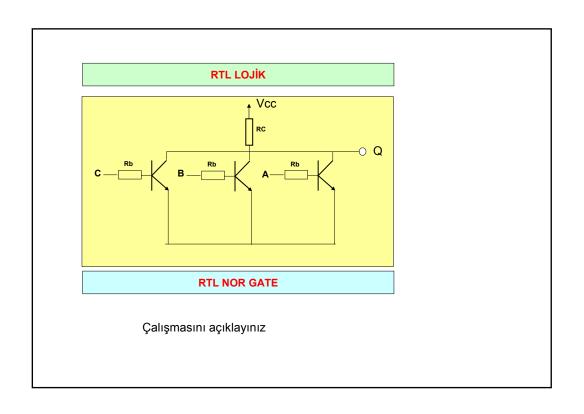
Örnek:  $V_A=V_B=5V$   $\rightarrow$  D1, D2 TIKAMADADIR. DOLAYISI İLE  $V_D=0$  V  $\rightarrow$   $V_E=$   $V_{CC}$  -  $V_{R1}$  -  $V_{D3}$  =  $V_E=$   $V_{CC}$  -  $V_{R1}$  - 0.6

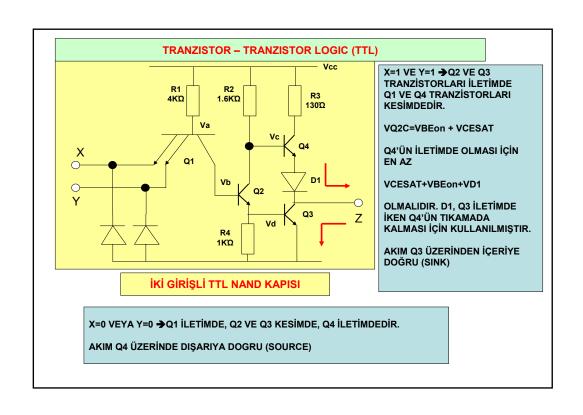


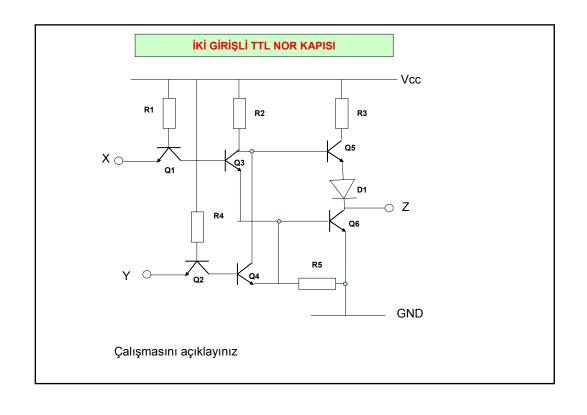
- D1 VE D2 DİYODLARI AND KAPISINI OLUŞTURUR.
- D3 VE D4 DİYODLARI TRANZİSTORU İLETİME GEÇİREN Vx GİRİŞ GERİLİMİNİ YÜKSELTMEKTİR.

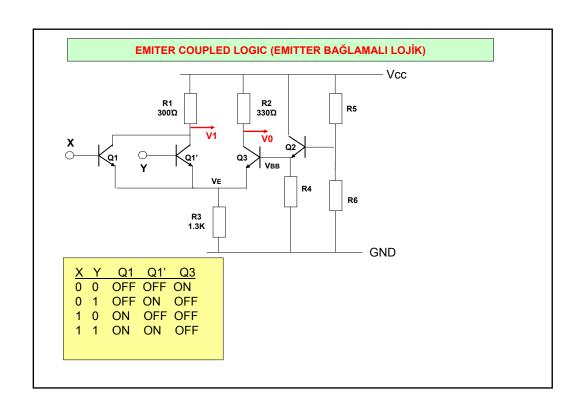
| Α | В | Vx   | Vy   | Tran. | Q |
|---|---|------|------|-------|---|
| 0 | 0 | <1.8 | <0.6 | OFF   | 1 |
| 0 | 1 | <1.8 | <0.6 | OFF   | 1 |
| 1 | 0 | <1.8 | <0.6 | OFF   | 1 |
| 1 | 1 | 1.8  | 0.6  | ON    | 0 |

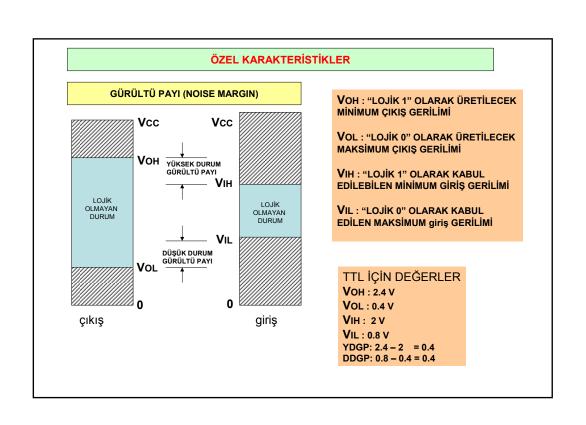


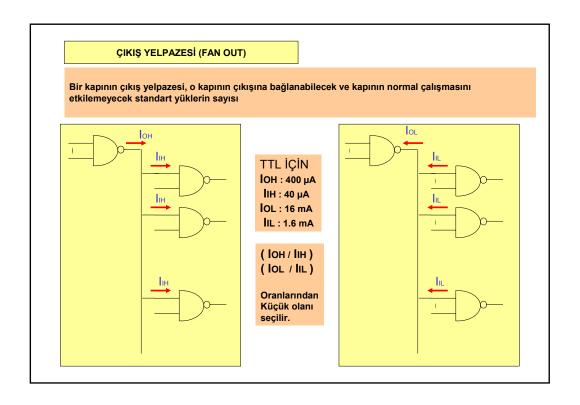


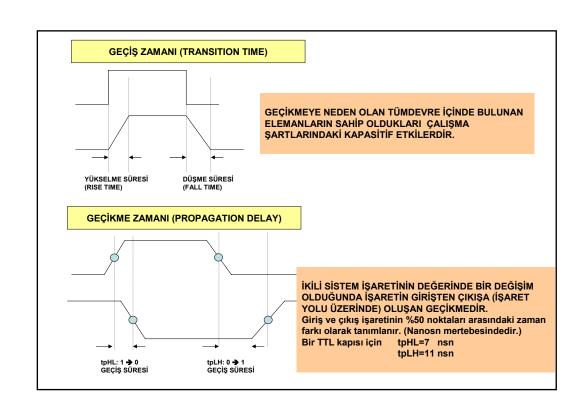












SORU: Aşağıdaki devrede bulunan elemanlar için propagation delay =0.01 mikrosn. dir. X girişi olarak verilen işarete karşın Y çıkış işaretini çiziniz.

X
A
B
C
y

## GÜÇ KAYBI (POWER DISSIPATION)

HER ELEKTRONİK DEVRE ÇALIŞMASI ESNASINDA BİR GÜÇ HARCAR. BU GÜÇ KAYBI Mw (mili WATT) OLARAK İFADE EDİLİR VE KAPININ İHTİYACI OLAN GÜÇ MİKTARINI BELİRLER.

BİR KAPIDA KAYBOLAN GÜÇ MİKTARI ÇEKİLEN ICC AKIMI VE BESLEME GERİLİMİ VCC İLE BELİRLENİR. GÜÇ=VCC X ICC

 $I_{ccH}$ =Kapının çıkışı yüksek gerilim seviyesinde iken güç kaynağından çekilen akım (TTL NAND kapısında Vcc=5V iken  $I_{ccH}$ =1 mA)

 $I_{ccL}$ =Kapının çıkışı düşük gerilim seviyesinde iken güç kaynağında çekilen akım(TTL NAND kapısında Vcc=5V iken  $I_{ccL}$ =3 mA)

Ortalama Güç kaybı

$$I_{\rm cc}$$
 (ort)= ( $I_{\rm ccH}$  +  $I_{\rm ccL}$ ) / 2

$$P_d$$
 (ort)=  $I_{cc}$  (ort) x  $V_{cc}$ 

